

拒絶理由通知書

| | |
|----------|--------------------|
| 特許出願の番号 | 平成 9年 特許願 第264225号 |
| 起案日 | 平成11年 5月24日 |
| 特許庁審査官 | 小原 博生 9814 2K00 |
| 特許出願人代理人 | 京本 直樹 (外 2名) 殿 |
| 適用条文 | 第29条第2項 |

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見があれば、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出されたい。

理 由

この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前頒布された下記の刊行物に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

請求項1～12、14～17：引用文献1～2

請求項13、18：引用文献1～3

備考：

(1) 請求項1～12、14～17について

引用文献1については、【0030】～【0033】、図9及び図10を参照されたい。

なお、n型基板を用い、p型半導体層を選択成長した利得導波型の半導体レーザは、引用文献2にも記載されているように、周知である。

(2) 請求項13、18について

続葉有

引用文献 3 は、活性層部分の結晶性を向上させるために、ダミーパターンを設けて、被覆率を制御する技術が記載されている。また、開口部の幅 W_1 を $1 \sim 2 \mu\text{m}$ 、 W_3 の幅を $1 \sim 10 \mu\text{m}$ 、そして、マスクの幅 W_2 、 W_4 を $5 \sim 30 \mu\text{m}$ とすることが記載されており、マスクの被覆率が 50% 以下のものを含んでいると認められる。

引用文献 1 に記載の発明においても、結晶性を向上させる課題があることは、明らかであるから、引用文献 1 に記載の窒化物半導体素子の形成において、上記技術を適用して本願の請求項 1 3 及び請求項 1 8 に係る発明のような構成とすることは、当業者が容易になし得るものである。

1. 特開平08-018159号公報
2. 特開平04-340284号公報
3. 特開平09-036473号公報

FAX 03-3580-6902

- ・調査した分野 I P C第6版 H01S3／18
 H01L21／205
 H01L21／31
- ・先行技術文献 特開平08－264454号公報
 特開平09－036475号公報
 特開平09－199791号公報

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではない。